

ロードロック式スパッタリング装置



特長

- ・コンパクト設計で実験・研究開発に最適
- ・フルオート制御が可能
- ・3ターゲット切替式で成膜(RF+DC重畳成膜が可能)

■ フットプリント : W2420 × D1230 (高さ1550mm)

■ 仕様

・スパッタ性能	形成膜	: 非磁性体金属、透明導電膜等
	膜厚分布	: □100mm内±5%以下 (ITO膜厚100nmにて)
	シート抵抗分布	: □100mm内±5%以下 (ITO膜厚100nmにて)
	シート抵抗	: 50 Ω/□以下 (ITO膜厚100nmにて)
	スパッタ方式	: スパッタアップ
	放電モード	: 高周波または直流マグネトロン放電 (重畳可)
	ターゲット	: 4インチ 3個
・スパッタガス		: Ar, O ₂
・基板サイズ		: 125mm × 125mm × 0.7~5mm ガラス基板 1枚
・基板加熱	最高温度	: 350°C
	温度分布	: 100~300°Cで±5°C以内
・基板回転		: 20rpm
・到達圧力	スパッタ室	: 1.0 × 10 ⁻⁴ Pa以下 (常温・無負荷、N ₂ リーク時)
・排気時間	ロードロック室	: 大気圧から10Paまで2分 (常温・無負荷、N ₂ リーク時)
	スパッタ室	: 大気圧から1.3 × 10 ⁻³ Paまで1時間以内 (常温・無負荷、N ₂ リーク時)
・操作モード		: 自動モード・手動モード
・電源		: φ3 AC200V 50/60Hz 13kVA